## 窒素吸着銅(001)面上に形成した コバルトナノドットの磁気モーメント

**中辻 寛 <sup>a)</sup>、飯盛 拓嗣 <sup>a)</sup>、高木 康多 <sup>a)</sup>、柳生 数馬 <sup>a)</sup>、木村 昭夫 <sup>b)</sup>、室 隆桂之 <sup>c)</sup>、<u>小森 文夫</u> <sup>a)</sup>東京大学・物性研究所、<sup>b)</sup>広島大学・大学院理学研究科、<sup>c)</sup>JASRI** 

背景: 微小な磁性体規則配列は、高密度磁気 記憶媒体や磁気抵抗デバイスなどナノテクノ ロジー分野への応用が期待されている。しかし ながら、数 nm サイズの磁性体を短時間で広い 面積にわたり均一に規則配列させることは、従来の技術では容易でなかった。最近開発された そのための唯一の方法として、表面の自己組織 形成ナノ規則パターンの利用がある。

これまで我々のグループは、平均して窒素が 0.3 原子層吸着した銅 (001) 面の正方格子パターン上にコバルトと鉄のナノドット規則配列を作成し、その構造と磁性の研究を行なってきた 1-3)。この系では、磁性金属の平均膜厚を変えることにより、1 原子層厚さの磁性金属正方格子および 2 原子層厚さのドット正方配列を作成することができる。格子およびドット配列の周期は 7nm である。図 1 に、2 原子層厚さのドット正方配列の周期は 7nm である。図 1 に、2 原子層厚さのドット正方配列の周期は 7nm である。図 1 に、2 原子層厚さのドット正方配列の走査トンネル顕微鏡(STM: Scanning Tunneling Microscope)像を示した。

このような磁性ドット配列では、孤立した微

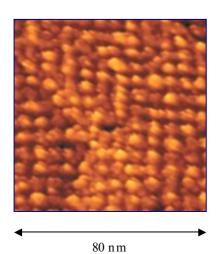


図1 コバルトドット配列

小磁性体の磁性およびそれがナノメートルス ケールの構造で繋がる際の磁気相互作用に興 味がもたれる。本研究の目的は、この系の磁性 を理解するために、コバルトの磁気モーメント および 3d 電子状態がその蒸着量の変化ととも にどのように変化していくかを、X線磁気円二 色性(XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism) スペクトル測定を用いて明らかにすることで ある。すでに、2原子層厚さのドットが孤立し ている状況では、バルクコバルトよりも大きい 軌道磁気モーメント成分を持つことがわかっ ているので、その膜厚変化を測定した。また、 ドットが窒素吸着面上にはみ出した状況での 窒素面の与える効果を調べるため、窒素が 0.5 原子層吸着した窒素飽和表面上にコバルトを 蒸着して測定を行った。窒素飽和表面上での STM による観察では、2 原子層厚さのドットが ランダムに配列することがわかっている<sup>3)</sup>。

実験: 実験は BL25SUの XMCD 装置を用いて行った。銅(001)表面の清浄化は、1keVのアルゴンイオン衝撃と 600℃の試料加熱を繰り返して行った。窒素吸着銅表面は、500eVの窒素イオンを打ち込んだ後、400℃に加熱することにより得た。この時、窒素の量を 0.5 原子層とすれば窒素飽和面を作ることができ、0.3 原子層程度とすれば銅(001)表面の正方格子パターンを作製できる。コバルトは、コバルト棒を電子衝撃加熱して、基板温度を室温に保って蒸着した。コバルトL吸収端の X線内殻吸収(XA: X-ray Absorption)スペクトルにおける XMCDは全電子収量法にて、試料温度 40K 以下で測

定した。試料の磁化は、永久磁石による 1.4T の連続磁場を表面垂直方向に印加して行い、円 偏光を磁場と平行に入射した。光スピンと磁化 が反平行な場合と 平行な場合との差分を XMCD として求めた。このとき円偏光の極性 は、挿入光源のキッカーマグネットを用いて 1Hz の変調をかけて切り替え、これと同期して 試料電流を測定した。これら一連の試料作製および測定は、超高真空(10-8 Pa 台)に保った試料 準備槽および測定槽にて行った。

**結果および考察**: 図2に、窒素飽和面におけるコバルトの平均膜厚が 1.6 原子層の場合の XA スペクトルと XMCD スペクトルを示す。2 原子層厚さのコバルトドットが互いに距離をおいて分布しており、マクロには超常磁性的にふるまうであろう。 得られたスペクトルに XMCD 総和則を適用し、スピン磁気モーメントに対する軌道磁気モーメントの比率  $(m_L/m_S)$  を求めた。窒素飽和面、銅正方格子、コバルトー様膜について、その膜厚依存性を比較したのが図 3 である。膜厚の減少に伴い $m_L/m_S$  が徐々に減少するのは、コバルトドット

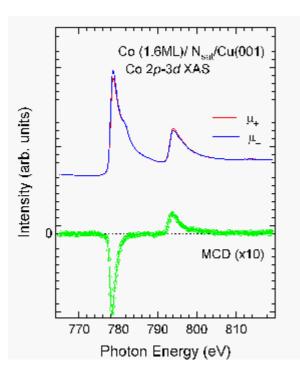


図2 コバルトドットの XA および XMCD スペクトル

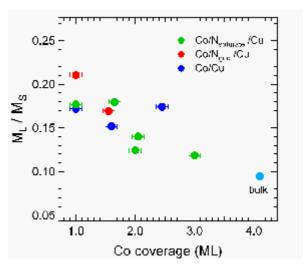


図3 m<sub>L</sub>/m<sub>S</sub>比の膜厚依存性

の低次元性に由来するものと考えられる。銅正 方格子の場合の変化の様子が窒素飽和面の場 合と大きくは異ならず、界面の窒素の存在は  $m_I/m_S$ 比に影響していないことがわかる。

一方、XA スペクトルの L<sub>3</sub>メインピークの約 3eV 高エネルギー側に、サテライト構造が見られる。この構造は、膜厚の増加とともに減少する。また、非常に微量のコバルトを銅清浄表面に蒸着した場合にも現れる。このことは、この構造がコバルトドットのサイズや形状に依存しており、d 電子の局在性を反映している可能性を示唆している。

**今後の課題**: サテライト構造の起源については、光電子分光などによる検証が必要である。またこれとは別に、コバルト-鉄多層ナノドット配列を作ることで磁化容易軸を制御したり、合金を用いて保磁力を制御できる可能性がある。XMCD により元素選択した磁気モーメントと 3d 電子状態の情報を得ることで、これら多層系/合金系ドットの磁性制御の基礎を固めることができるであろう。

## 参考文献

- 1) K.D. Lee et al., Surf. Sci. 454-456, 860 (2000).
- F. Komori *et al.*, Phys. Rev. **B63**, 214420 (2001),
  J. Phys.:Condens. Matter **14**, 8177 (2002).
- 3) S. Ohno et al., Surf. Sci. 493, 539 (2001).